



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HS669A

对应国外型号
2SD669A

主要用途

作低频功率放大。

极限值 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度…………… $-55\sim 150^{\circ}\text{C}$

T_j ——结温…………… 150°C

P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$) ……………20W

P_C ——集电极功率耗散 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$) ……………1W

V_{CBO} ——集电极—基极电压……………180V

V_{CEO} ——集电极—发射极电压……………160V

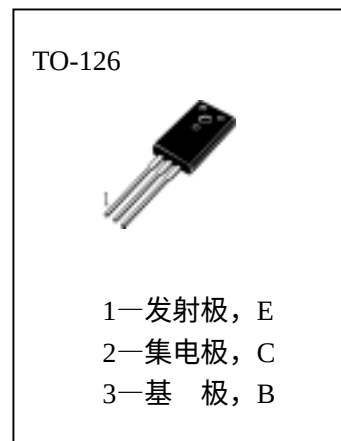
V_{EBO} ——发射极—基极电压……………5V

I_C ——集电极电流……………1.5A

电参数 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	180			V	$I_c=1\text{mA}$, $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	160			V	$I_c=10\text{mA}$, $R_{\text{EB}}=\infty$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	5			V	$I_E=1\text{mA}$, $I_c=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			10	μA	$V_{\text{CB}}=160\text{V}$, $I_E=0$
H_{FE1}	直流电流增益	60		200		$V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_c=150\text{mA}$
H_{FE2}		30				$V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_c=500\text{mA}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和压降			1	V	$I_c=500\text{mA}$, $I_B=50\text{mA}$
V_{BE}	基极—发射极压降			1.5	V	$V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_c=150\text{mA}$
f_T	特征频率		140		MHz	$V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_c=150\text{mA}$
C_{ob}	输出电容		14		pF	$V_{\text{CB}}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$

外形图及引脚排列



分档及其标志

B

C

60—120

100—200